

	<h2>HUFA76629D3ST</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUFA76629D3ST</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUFA76629D3ST.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


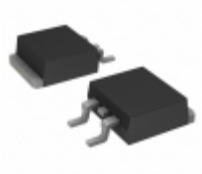

Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76629D3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 20A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1285pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 20A (Tc) 110W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

HUFA76629D3ST Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUFA76629D3ST-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUFA76629D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HUFA76629D3ST E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUFA76629D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUFA76629D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUFA76633S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>	 <p>HUFA76633S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>
 <p>HUFA76633S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>	 <p>HUFA76633P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p>HUFA76633P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p>HUFA76629D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUFA76629D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUFA76629D3ST Datenblatt	HUFA76629D3ST-Datenblätter	HUFA76629D3ST PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUFA76629D3ST
HUFA76629D3ST Electronic	HUFA76629D3ST-Komponenten	HUFA76629D3ST-Verteiler	HUFA76629D3ST-Bild	HUFA76629D3ST-Teil
HUFA76629D3ST Preis	HUFA76629D3ST Hersteller	HUFA76629D3ST Bild	HUFA76629D3ST Aktie	HUFA76629D3ST Inventar
HUFA76629D3ST Neu	HUFA76629D3ST Original	HUFA76629D3ST garantiert	HUFA76629D3ST RFQ	HUFA76629D3ST Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited